News Release

2011 年 1 月 25 日

報　道　各　位

「無電解 Ni/(Pd)/Au UBM めっきライン」の大幅増設について

JX日鉱日石金属株式会社（本店：東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 3 号　社長：岡田昌徳　以下「当社」）は，この程当社磯原工場（茨城県北茨城市）において，「無電解ニッケル/(パラジウム)/金メッキプロセスによるUBM（Under Bump Metallurgy アンダー・バンプ・メタラジー）」*1のラインを大幅に増設いたしました。新ラインは，本年 2 月に本格稼動する予定です。この増設により，処理能力は現行の約 10,000 枚/月から 25,000～30,000 枚/月に大幅に増強することが可能となります。

今般の新ラインの増設は，当社が 2008 年 1 月以降に提供してきたUBM形成サービスをさらに充実させ，半導体デバイスのフリップチップ実装*2化の需要の高まりに応えていくことを目的としています。また，大型の 12”ウェハに対しても，本サービスをより柔軟にご採用いただくことが可能となります。

なお，一昨年より開始した本サービスの下工程にあたる「はんだバンピングサービス」の設備能力の増強についても検討中であります。当社は，今後も予想されるより小型化・高性能化したデバイスへのご要求に対応すべく，本サービスおよびはんだバンピングサービスの更なる充実を図ってまいります。

*1UBM（アンダー・バンプ・メタラジー）：
はんだバンプの下地となる金属層のことで、IC 金属を保護し、はんだの拡散防止の役割を果たすとともに，はんだとの良好な接合を確保することを目的としています。

*2 フリップチップ実装：
基板上へチップを実装する方法の１種です。チップ表面と基板を，ワイヤ・ボンディングによらず，バンプと呼ばれる突起状の端子によって接続する方法です。ワイヤ・ボンディングによる場合と比較して実装面積を小さくすることができ，さらに配線を短くすることからより良い電気的特性を実現できます。

JX 日鉱日石金属株式会社　総務部　　〒100-8164 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 3 号　　TEL:03-5299-7081

（ご参考）

本サービスの標準仕様

ウェハ材質	Si, GaAs 等
ウェハサイズ	4”～12”
パッド材質	Al, AlSi, AlCu, AlSiCu, Cu
UBM 仕様	無電解 Ni/Au, Ni/Pd/Au
Ni/Au 仕様	Ni：P 品位 5～10%,厚み 1～5μm Au：厚み 0.05～0.5μm
Ni/Pd/Au 仕様	上記 Ni/Au に Pd (0.05～0.1μm)めっき

以上

JX 日鉱日石金属株式会社　総務部　　〒100-8164 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 3 号　　TEL:03-5299-7081